

NEW LINEUP

高温CVD装置

NEW LINEUP

面発光レーザー作製用酸化装置

SiC用CVD装置 (HTC3000)



※本装置はNEDOが委託している
新機構素子研究開発協会先進パワーデバイス研究所に納入しました。

- リアクタ: 縦型石英製
フェイスダウン
- 投入室: トランスファーロード付
- 基板サイズ: φ3インチ×1枚
- 基板加熱: 高周波加熱方式
- 最高加熱温度: 1800°C (放射温度計値)
- 適用: SiCなど

オール・イン・ワンCVD装置



奈良先端科学技術大学院大学納入設備

- リアクタ: 横型石英製
- 基板サイズ: φ2インチ×1枚
- 基板加熱: 高周波加熱方式
- 最高加熱温度: 1500°C (放射温度計値)
- フットプリント: 1.3m×1.3m
- 適用: SiCなど

高温CVD装置 (SH2001-HTA)



名城大学納入設備

- リアクタ: 横型ステンレス製
フェイスダウン
- 基板サイズ: φ1インチ×1枚
- 基板加熱: 抵抗加熱方式
- 最高加熱温度: 1800°C (制御用熱電対値)
- 適用: AlNなど

特許申請中

高温CVD装置・酸化装置 (OV4001)



- リアクタ: 縦型ステンレス製
- 基板サイズ: φ4インチ×1枚
- 基板加熱: 抵抗加熱方式
- 最高加熱温度: 1400°C (制御用熱電対値)
- 適用: SiC酸化プロセスなど

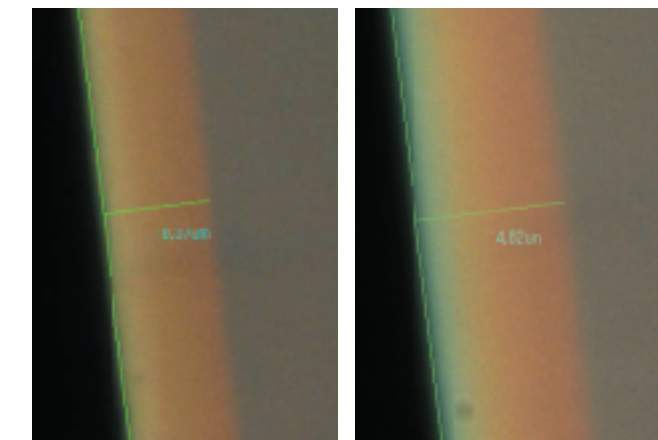
特許取得済

iVOX3001 (モニター付) / VOX3001

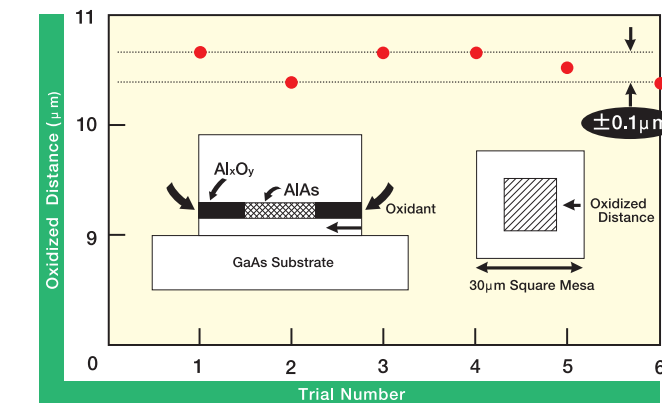


- 基板サイズ: φ3インチ×1枚
- 基板加熱: 抵抗加熱方式
- 最高加熱温度: 600°C (制御用熱電対値)
- 原料供給系: 液体マスフローコントローラ方式
熱式気化器 (Max.180°C)
- 真空排気系: ダイアフラムポンプ
- 制御装置: インターロック用シーケンスコントローラ
- 酸化性能: 面内均一性/20μm±0.2μm
(周辺部除く3インチ基板面内)
再現性/20μm±0.2μm
(ラン to ラン)
※但しAlAsエピ層の特性による。
- モニター画像: 画像は酸化評価用サンプル
(iVOX3001) (光学倍率: 50倍)

特許取得済



- 酸化温度: 450°C
- 酸化時間: 10分
- 酸化幅: 10μm
- 酸化温度: 450°C
- 酸化時間: 15分
- 酸化幅: 15μm



東京工業大学小山研究室様ご提供
(Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 39(2000)PP. 3468-3469)